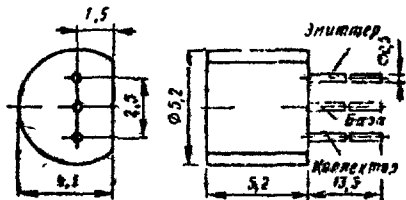


КТ375А, КТ375Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры при универсальных. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,25 г.

КТ375(А, Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 2 В, I_B = 20 мА$.

$T = +25^{\circ}C$

КТ375А

КТ375Б

10 100
50 200

$T = -45^{\circ}C$

КТ375А

КТ375Б

8...100
25...280

$T = +85^{\circ}C$

КТ375А

КТ375Б

10 200
50 560

Граничная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 10 В, I_K = 5 мА$, не менее

250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 10 В,$

300 нс

$I_B = 5 мА$, не более

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K =$

0,4 В

$= 10 мА, I_B = 1 мА$, не более

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K = 10 мА,$

1 В

$I_B = 1 мА$, не более

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ макс}$, не более:

$T = +25^{\circ}C$

$T = +85^{\circ}C$

1 мкА
10 мкА
1 мкА
5 пФ
20 пФ

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5 В$, не более

мкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10 В$, не более

мкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1 В$, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — эмиттер при $R_{об} \leq 100 Ом$:

КТ375А

КТ375Б

60 В
30 В
100 мА

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при $t_{им} \leq 1 мкс$ и условии, что

средняя мощность за период не превышает постоянную

рассеиваемую мощность коллектора

200 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T =$

200 мВт

$-45...+25^{\circ}C$

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_{им} \leq$

1 мкс и условии, что средняя мощность за период не

превышает постоянную рассеиваемую мощность коллектора

400 мВт
+125^{\circ}C

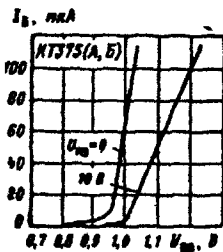
температура р-п перехода

температура окружающей среды

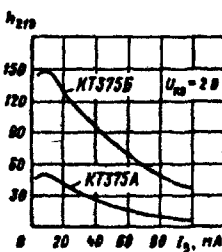
-45...+85^{\circ}C

¹ В диапазоне температур $+25...+85^{\circ}C$ мощность определяется по формуле $P_{К. макс} = (125 - T) / 0,5$.

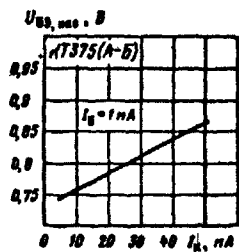
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора.



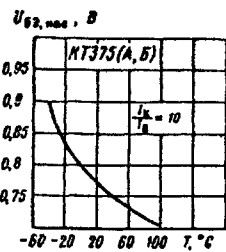
Входные характеристики



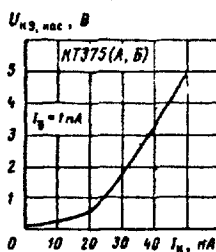
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



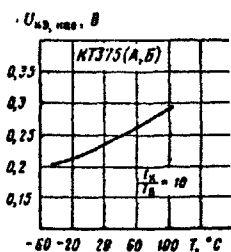
Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от температуры



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от температуры